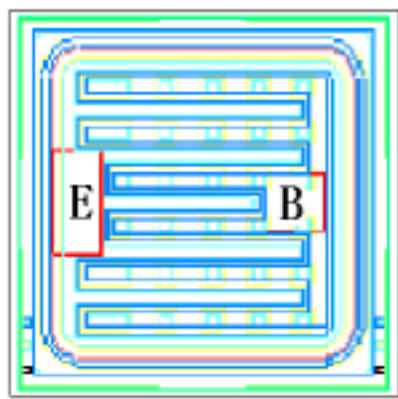




## 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）  
 芯片代码：A080BJ-03  
 芯片厚度：240 ± 20μm  
 管芯尺寸：800 × 800μm<sup>2</sup>  
 焊位尺寸：B 极 124×124μm<sup>2</sup>；E 极 221×110μm<sup>2</sup>  
 电极金属：铝  
 背面金属：金  
 典型封装：KSA928A，H928S

## 管芯示意图



## 极限值 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-92)

T<sub>stg</sub>——贮存温度..... -55~150  
 T<sub>j</sub>——结温.....150  
 P<sub>C</sub>——集电极耗散功率.....0.75W  
 V<sub>CB0</sub>——集电极—基极电压.....-30V  
 V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压.....-30V  
 V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压.....-5V  
 I<sub>C</sub>——集电极电流..... -2A

## 电参数 (T<sub>a</sub>=25 ) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV <sub>CBO</sub>	集电极—基极击穿电压	-30			V	I <sub>C</sub> =-100μA, I <sub>E</sub> =0
BV <sub>CEO</sub>	集电极—发射极击穿电压	-30			V	I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =0
BV <sub>EBO</sub>	发射极—基极击穿电压	-5			V	I <sub>E</sub> =-1mA, I <sub>C</sub> =0
I <sub>CBO</sub>	集电极—基极截止电流			-100	nA	V <sub>CB</sub> =-30V, I <sub>E</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			-100	nA	V <sub>EB</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE</sub>	直流电流增益	100		320		V <sub>CE</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =-500mA
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和电压			-2	V	I <sub>C</sub> =-1.5A, I <sub>B</sub> =-30mA
V <sub>BE(on)</sub>	基极—发射极导通电压			-1	V	V <sub>CE</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =-500mA
f <sub>T</sub>	特征频率		120		MHz	V <sub>CE</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =-500mA
C <sub>ob</sub>	共基极输出电容		30		pF	V <sub>CB</sub> =-10V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz